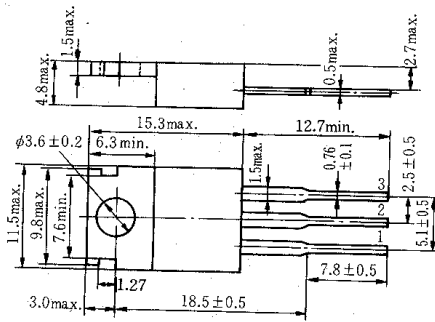


# 2SD1131, 2SD1132

シリコン NPN 三重拡散形  
低周波電力増幅用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED  
LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER



(JEDEC TO-220AB)

1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector  
(フランジ) (Flange)
3. エミッタ: Emitter  
(Dimensions in mm)

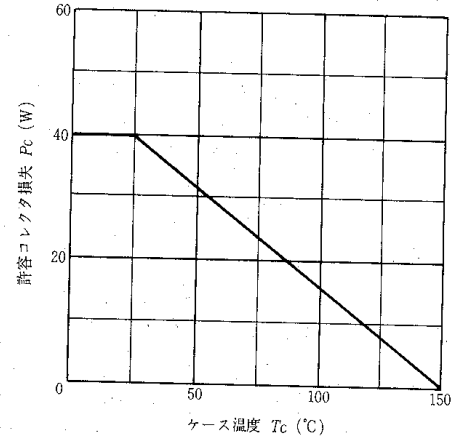
## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SD1131	2SD1132	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	50	60	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	50	60	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	4	4	V
コレクタ電流	$I_C$	4	4	A
許容コレクタ損失	$P_C^*$	40	40	W
接合部温度	$T_j$	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-45~+150	-45~+150	$^\circ\text{C}$

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	2SD1131			2SD1132			Unit
			min	typ	max	min	typ	max	
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=5\text{mA}, I_E=0$	50	—	—	60	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	50	—	—	60	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=5\text{mA}, I_C=0$	4	—	—	4	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$	—	—	100	—	—	100	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE1}^*$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=1\text{A}^{**}$	60	—	320	60	—	320	
直流電流増幅率	$h_{FE2}$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.1\text{A}^{**}$	35	—	—	35	—	—	
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=1\text{A}^{**}$	—	0.85	1.5	—	0.85	1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.2\text{A}^{**}$	—	0.5	1.0	—	0.5	1.0	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.5\text{A}^{**}$	—	8	—	—	8	—	MHz

\*2SD1131, 2SD1132は  $h_{FE1}$  の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

\*The 2SD1131 and 2SD1132 are grouped by  $h_{FE1}$  as follows.

B	C	D
60~120	100~200	160~320

\*\*パルス測定

\*\* Pulse Test